

Literatura

- /1/ Koňáková, A., Sopko, B.: Speciální praktikum- Fyzika pevných látek .
Skriptum ČVUT, Praha 1986
- /2/ Frank, H.: Měřicí metody polovodičů. Skriptum ČVUT, Praha 1967
- /3/ Frank, H., Šnejdar, V.: Principy a vlastnosti polovodičových součástek.
SNTL, Praha, 1976
- /4/ Ziegler, J., F. : Ion Implantation Science and Technology, Academic Press,
1988
- /5/ Rybka, V.: Měření v elektrotechnice. Skriptum ČVUT, Praha 1982
- /6/ Veeco: The two - configuration technique in four point probe measurements.
Application note N° 302
- /7/ Logan, M., A.: Bell Syst. Tech. J. 40 (1961), 885
- /8/ Ryssel, H., Ruge, I.: Ionenimplantation, B.G. Teubner, Stuttgart 1978
- /9/ Schwarzeudruber, L., J.: NBS, Techn. Note 199, 1964
- /10/ Ryssel, H., Glawischning, H.: Ion Implantation Techniques, Springer,
Berlin 1982
- /11/ Irwin, J., C.: Bell Tech. J., 41 (1962), 387
- /12/ Kopsa, K.: Vliv technologických operací na aktivaci implantovaných
příměsí. Diplomová práce FEL ČVUT, Praha 1989
- /13/ May, J., Zamastil, J.: Proceedings of Shanghai Workshop on Ion Implantati-
on Shanghai 1988, 154
- /14/ Sze, S., M. : VLSI Technology, Mc Graw-Hill, New York 1983
- /15/ Frank, H.: Profilování implantovaných a tenkých difundovaných struktur.
Experimentální metody fyziky pevných látek. MFF UK, 1986
- /16/ Frank, H.: Fyzika a technika polovodičů., SNTL Praha 1990
- /17/ Sze, S., M.: Physics of Semikonduktor Devices, Wiley, 1981
- /18/ Wof, S., Tauber, R., N.: Silicon Processing for the VLSI Era, Lattice
Press, Sunset Beach
- /19/ Current, M., I., Keenan, W., A. : Solid State Technol., 28 (1985), 139
- /20/ Market, M. J., Current, M., I. : Solid State Technol. 26 (1983), 101
- /21/ Keenan, W., A., Johnson, W., H., Smith, A., K.: Solid State Technol. 28 (1985)
143
- /22/ Keenan, W., A., Johnson, W., H.: Nucl. Instr. and Meth. B 55 (1991), 230
- /23/ Yarling, C. B., Keenan, W., A., Larson, L., A.: Nucl. Instr. and Meth.
B 55 (1991), 235
- /24/ Glawischning, H., Lang, G.: Proc. 7th Int. Conf. on Ion Implantation
Technology, Kyoto, Japan, 1988, ed. T. Takagi,
Nucl. Instr. and Meth. B 37/38 (1989), 628
- /25/ Larson, L., A.: J. Electrochem. Soc. 136 (1988), 1802
- /26/ Deming, R. O., Keenan, W., A.: Solid State Technol. 28 (1985), 163
- /27/ Hull, J., M. et al : IEEE Trans. on El. Dev., ED-23 (1976), 809
- /28/ Hnatowicz, V.: Studium polovodičů metodou RBS In: Experimentální metody
fyziky pevných látek, sv. 8, MFF UK, Praha 1987, 134
- /29/ Aplikace jaderných metod v ÚJF ČSAV, Výzkumná zpráva Řež 1985
- /30/ Alves, E., Da Silva, M., F., Acores, J., C., Melo, A., A., May, J.,
Hašlar, V., Seidl, P., Feuser, V., Vianden, R.: Nucl. Instr. and Meth.
B 55 (1991), 580
- /31/ Janů, M., Štverák, B.: Využití radionuklidových metod v elektronice,
Křemík 88 díl 2, Tesla Rožnov 1988, 105

- /32/ Haas, E., W., Hofmann, R.: Solid-State Electronics, (1987), 329
- /33/ Hedbávný, P., Šroubek, Z.: Hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů.
Experimentální metody fyziky pevných látek. sv.8 MFF UK
Praha 1987
- /34/ Eckertová, L.: Metody analýzy povrchů. Experimentální metody fyziky
pevných látek, sv. 4, MFF UK, Praha 1982
- /35/ Gricová, M.: Metody analýzy materiálů, Skriptum ČVUT, Praha 1988
- /36/ Hůlek, Z.: Metody studia povrchů pevných látek, Skriptum ČVUT, Praha 1983
- /37/ Eckertová L.: Elektronika povrchů, SPN, Praha 1983
- /38/ Fesič, V., Veselý, M., Harman, R.: Studium GaAs metodou SIMS
In: Experimentální metody fyziky pevných látek, red. P. Lukáč
MFF UK, Praha 1987, 146
- /39/ Roháček, K.: Studium povrchu amorfních polovodičových materiálů na bázi
křemíku metodou SIMS.: Experimentální metody fyziky pevných
látek, sv. 8, MFF UK, Praha, 1987, 156
- /40/ Lederhandler, S., R., Gi a coletto, L.: Proc. IRE. 43 (1955), 477
- /41/ Burian, Z., Třeštková, V.: Diagnostika v mikroelektronice, Skriptum ČVUT,
Praha 1982
- /42/ Nicollian, E., Brews, J., R.: MOS Physics and Technology New York, J. Wiley
1982
- /43/ Marciniak, W.: Polovodičové součástky typu MIS, SNTL, Praha 1979
- /44/ Výzkum štruktúr MIS a pasivácie. Výzkumná zpráva SVŠT, Bratislava 1980
- /45/ Hazdra, P.: Metody studia lokalizovaných stavů v polovodičích, práce ke
kand. minimu, ČVUT, Praha 1988
- /46/ Hazdra, P.: Využití metody DLTS pro studium kontaminace polovodiče
těžkými kovy, zpráva SVU A 07-119-815, FEL ČVUT, 1987
- /47/ Milnes A. G.: Deep Impurities in Semiconductors. J. Wiley, New York 1973
- /48/ Kejhar, M.: Impulzové metody pro studium povrchu polovodičů, Diplomová
práce, FEL ČVUT, Praha 1986
- /49/ Kejhar: Práce ke kand. minimu, FEL ČVUT, Praha
- /50/ Hang A.: Theoretical solid state physics, Pargamon Press, New York 1972
- /51/ Frank, H.: Čs. čas. fyz. A, 23 (1973), 253
- /52/ Frank, H.: Čs. čas. fyz. A, 35 (1985), 339
- /53/ Thurzo, I., Kresáková, K., Michalička, O.: Čs. čas. fyz. A 32 (1982)
- /54/ Klier, E.: Studium povrchů polovodičů metodou termotimulovaných proudů.
Experimentální metody fyziky pevných látek, sv. 6, MFF UK,
Praha 1986
- /55/ Harmatha, L.: Určení generačních parametrů nerovnovážnou metodou měření
napěťové závislosti kapacity struktury MIS v hlubokém
ochuzení. Experimentální metody fyziky pevných látek,
sv. 6, MFF UK, Praha 1986
- /56/ Dubecký, F.: Základy kapacitní spektroskopie. Experimentální metody
fyziky pevných látek, sv. 6, MFF UK, Praha 1986
- /57/ Bartoš, J.: Aplikace metody DLTS na analýzu mono - Si. Křemík 88 díl 2.
Tesla Rožnov 1988, 98
- /58/ Greudel, M., Bartoš, J.: Určení aktivační energie, koncentrace a
záchytné průřezy pastí na rozhraní SiO_2/Si
z nábojových DLTS spekter měřených malým signálem.
Křemík 88, díl 2., Tesla Rožnov 1988, 209

- /59/ Vojtěchovský, K.: Diagnostické metody pro hodnocení vlastností křemíku.
Křemík 88, díl 1., Tesla Rožnov 1988, 184
- /60/ Opsal, J. et al.: Applied Optics, 22 (1983) , 3169
- /61/ Golin, J.,R., Schell, N., W., Glaze, J.,A.:Advanced methods of ion
implant monitoring using optical dosimetry. Solid State
Technology - technical publishing, 1985
- /62/ Vojtěchovský, K.: Optická spektroskopie pro stanovení koncentrace příměsí
v Si. Křemík 88, díl 2., Tesla Rožnov 1988, 48
- /63/ Kaslík, Z.: Parametry monokrystalů křemíku a jejich hodnocení.
Křemík 88, díl 1., Tesla Rožnov 1988, 133
- /64/ Kuběna, J., Holý V.: Czech. J. Phys. B 33 (1983) , 1315
- /65/ Kuběna, J., Holý, V.: Czech. J. Phys. B 34 (1984), 950
- /66/ Kuběna, J.: Strukturální dokonalost monokrystalů Si a tvorba defektů.
Křemík 88, díl 2., Tesla Rožnov 1988, 113
- /67/ Holý, V., Kuběna, J.: Czech. J. Phys. B 29 (1979) ,161
- /68/ Kuběna, J.: Charakterizace křemíku pro výrobu integrovaných obvodů.
Experimentální metody fyziky pevných látek, sv. 6.,
MFF UK, Praha 1986, 3
- /69/ Vojtěchovský, K. : Metody měření a hodnocení polovodičových materiálů
Aktuality technologie a konstrukce polovodičových součástek
Tesla, Tesla Rožnov 1987, 76
- /70/ Kuběna, J., Hlávka, V.: Phys. stat. sol. (a) 89 , K 23 (1985)
- /71/ Alter, U., Härtwig, J., Kuběna, J.: Czech. J. Phys. B 35 (1985) ,158
- /72/ Kuběna, J.: Pokroky mat., fyz. a astr. 30 (1985), 267
- /73/ Pelant, I., Hála, J., Ambrož, M., Kohlová, V.: Fotoluminiscence příměsí
a fotoluminiscenční stanovení boru a fosforu v křemíku.
Křemík 88, díl 2., Tesla Rožnov 1988, 86
- /74/ Engst, P., Horák, M.: Aplikace laserů, SNTL, Praha 1989
- /75/ Kuběna, J., Holý, V., Banáš, S.: Sledování strukturních poruch v Si
rtg. metodami. Křemík 88, díl 2., Tesla Rožnov 1988, 157
- /76/ Holý, V., Kuběna, J.: Rentgenografické stanovení velikosti a hustoty
mikrodefektů. Křemík 88, díl 2., Tesla Rožnov 1988
167
- /77/ Ohlídal, I., Vojtěchovský, K.: Optické metody pro diagnostiku tenkých
vrstev. 6. čs konference o tenkých vrstvách,
I. díl Mariánské lázně 1987, 69
- /78/ Lenhard, R.: Defekty v křemíku a jejich souvislost s výtěžností IO,
Aktuality technologie a konstrukce polovodičových součástek
Tesla, část 2, Tesla Rožnov 1987, 121
- /79/ Šátala, Z., Gogol, P.: Analýza výtěžnosti výroby IO. Sborník ze IV. semi-
náře Testovací struktury a modelování v
mikroelektronice, Zuberec 1989
- /80/ Byru, V.G., Volkenštejn, F., F.: Vlijanije oblučeniya na poverchnostnyye
svoystva poluprovodnikov, Nauka Moskva
1978
- /81/ Eckertová, L.: Physics of thin films, Plenum press, New York, 1986
- /82/ Pacáková, V., Štulík, K.: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie,
SPN, Praha 1986
- /83/ Jaros, M.: Deep levels in semiconductors, Adam Hilger, Bristol 1982

- /84/ Pína, L.: Měření hloubkových koncentračních profilů a zpětnovazební kapacitní metoda. Kand. disert. práce FJFI ČVUT, 1978
- /85/ Kaliteevskij, N.I.: Volnovaja optika "Vysšaja škola.", Moskva 1978
- /86/ Sivuchin, D., V.: Obščij kurs fiziky, Nauka, Moskva 1985
- /87/ Hůlek, Z., : Metody studia povrchů pevných látek. Skriptum ČVUT, Praha 1983
- /88/ Klier, E.: Optika. Skriptum. MFF UK, SPN, Praha 1978
- /89/ Volrábová, H.: Měření tloušťky SiO_2 na křemíku elipsometrickou metodou. Výzkumná zpráva Z7217, SVUOM Praha
- /90/ Brdička, B., Dvořák, J.: Základy fyzikální chemie. Academia Praha 1977
- /91/ Kalous, V.: Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul. SNTL, Praha 1983
- /92/ Vacík, J.: Obecná chemie. SNTL, Praha 1986
- /93/ Mathur, M. S., et al.: Nucl. Instr. and Meth. B 55 (1991), 671
- /94/ Adamčík, I., Malý, L.: Unifikované testovací struktury pro integrované obvody. IV. seminář Testovací struktury a modelování v mikroelektronice, Zuberec 1989
- /95/ Daniška, V.: Využití metody EBIC v mikroelektronice, Experimentální metody fyz. pevných látek, sv. 8., MFF UK, 1987, 34
- /96/ Kolomazník, Z: Spolehlivost. Aktuality technologie a konstrukce polovodičových součástek Tesla, Rožnov 1987, 25
- /97/ Kvaček, R.: Diagnostika implantovaných vrstev. Diplomová práce, FEL ČVUT, Praha 1988
- /98/ Hemment P., L., F. et al: Nucl. Instr. and Meth. B 21 (1987), 129
- /99/ Hemment P., L., F. et al: Appl. Phys. letd. 46 (1985), 952
- /100/ Hoříňka, J.: Studium procesů v systému Si- SiO_2 pomocí testovacích struktur. Výzkumná zpráva Tesla Rožnov 1978
- /101/ Bastl, Z.: Studium polovodičů metodami fotoelektronové spektroskopie Experimentální metody fyziky pevných látek, sv. 8, MFF UK, Praha 1987, 121
- /102/ Jones, K.S., Prussin, S., Weber, E.R. : Appl. Phys. A 45 (1988), 1
- /103/ Rosák, T.: Technologie vytváření mělkých přechodů PN v křemíku, Diplomová práce ČVUT, Praha 1989
- /104/ Vaniček, F.: Polovodičové struktury, skriptum ČVUT, Praha 1986